1. **Aritsuki Takuya, Nakashima Takeshi, Kobayashi Keisuke, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Epitaxial graphene on SiC formed by the surface structure control technique, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.55,** *No.6,* 06GF03-(4pp), 2016.
2. **Susumu Iida, Kaoru Ohya, Ryoichi Hirano *and* Hidehiro Watanabe :** An analysis of the impact of native oxide, surface contamination and material density on total electron yield in the absence of surface charging effects, *Applied Surface Science,* **Vol.384,** 244-250, 2016.
3. **Yasuhide Ohno, Yasushi Kanai, Yuki Mori, Masao Nagase *and* Kazuhiko Matsumoto :** Top-gated graphene field-effect transistors by low-temperature synthesized SiNx insulator on SiC substrates, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.55,** *No.6S1,* 06GF09, 2016.
4. **Z. Shen, L. He, Jin-Ping Ao, B.J. Zhang *and* Y. Liu :** Investigation of O3-Al2O3/H2O-Al2O3 dielectric bilayer deposited by atomic-layer deposition for GaN MOS capacitors, *Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science,* **Vol.213,** *No.10,* 2693-2698, 2016.
5. **Hisatomo Matsumura, Shin-ichiro Yanagiya, Masao Nagase, Hiroki Kishikawa *and* Nobuo Goto :** Microscopic Raman Study of Graphene on 4H-SiC Two-Dimensionally Enhanced by Surface Roughness and Gold Nanoparticles, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.55,** *No.6S1,* 06GL05, 2016.
6. **Yuyu Bu, Zhiwei Chen, Tian Xie, Weibing Li *and* Jin-Ping Ao :** Fabrication of C3N4 ultrathin flakes by mechanical grind method with enhanced photocatalysis and photoelectrochemical performance, *RSC Advances,* **Vol.6,** 47813-47819, 2016.
7. **Yuusuke Takashima, Masato Tanabe, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Highly polarized emission from a GaN-based ultraviolet light-emitting diode using a Si-subwavelength grating on a SiO2 underlayer, *Optics Communications,* **Vol.369,** 38-43, 2016.
8. **Jiaqi Zhang, Lei Wang, Qingpeng Wang, Ying Jiang, Liuan Li, Huichao Zhu *and* Jin-Ping Ao :** Self-Aligned-Gate AlGaN/GaN Heterostructure Field-Effect Transistors with Titanium Nitride Gate, *Chinese Physics B,* **Vol.25,** *No.8,* 087308, 2016.
9. **Taniguchi Yoshiaki, Miki Tsubasa, Mitsuno Takanori, Yasuhide Ohno, Masao Nagase, Keiji Minagawa *and* Mikito Yasuzawa :** Fabrication of hydrophilic graphene film by molecular functionalization, *Physica Status Solidi (B) Basic Solid State Physics : PSS,* **Vol.254,** *No.2,* 1600524-(4pp), 2016.
10. **Tong Zhang, Liuan Li *and* Jin-Ping Ao :** Temperature-dependent electrical transport characteristics of a NiO/GaN heterojunction diode, *Surfaces and Interfaces,* **Vol.5,** 15-18, 2016.
11. **Tatsuya Okada, Takuro Tomita, Tomoyuki Ueki, Yuki Masai, Yota Bando *and* Yasuhiro Tanaka :** Femtosecond laser-induced modification at aluminum/diamond interface, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.56,** *No.2,* 026601-1-026601-5, 2017.
12. **Masaharu Nishikino, Noboru Hasegawa, Takuro Tomita, Yasuo Minami, Takashi Eyama, Naoya Kakimoto, Rui Izutsu, Motoyoshi Baba, Tetsuya Kawachi *and* Tohru Suemoto :** Formation of x-ray Newton's rings from nano-scale spallation shells of metals in laser ablation, *AIP Advances,* **Vol.7,** *No.1,* 015311-1-015311-5, 2017.
13. **Yuusuke Takashima, Masato Tanabe, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Theoretical investigation of polarization control in ultraviolet wavelength region using eigenmode within subwavelength grating, *Optical Review,* **Vol.24,** *No.1,* 80-86, 2017.
14. **Retsuo Kawakami, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano *and* Takashi Mukai :** AlGaN Surfaces Etched by CF4 Plasma with and without the Assistance of Near-Ultraviolet Irradiation, *Vacuum,* **Vol.136,** 28-35, 2017.
15. **Yuyu Bu *and* Jin-Ping Ao :** A Review on Photoelectrochemical Cathodic Protection Semiconductor Thin Films for Metals, *Green Energy & Environment,* **Vol.2,** *No.4,* 331-362, 2017.
16. **Lei Wang, Jiaqi Zhang, Liuan Li, Yutaro Maeda *and* Jin-Ping Ao :** Plasma-assisted surface treatment for low-temperature annealed ohmic contact on AlGaN/GaN heterostructure field-effect transistors, *Chinese Physics B,* **Vol.26,** *No.3,* 037201, 2017.
17. **Lei Wang, Yuyu Bu *and* Jin-Ping Ao :** Effect of oxygen plasma treatment on the performance of AlGaN/GaN ion-sensitive eld-effect transistors, *Diamond and Related Materials,* **Vol.73,** *No.3,* 1-6, 2017.
18. **D. Terasawa, A. Fukuda, A. Fujimoto, Yasuhide Ohno, Y. Kanai *and* K. Matsumoto :** Relationship between conductance fluctuation and weak localization in graphene, *Physical Review B,* **Vol.95,** *No.12,* 125427, 2017.
19. **Wang Lei, Bu Yuyu, Li Liuan *and* Jin-Ping Ao :** pH sensitivity of AlGaN/GaN heterostructure ion-sensitive field-effect transistors with thermal oxidation treatment, *Applied Surface Science,* **Vol.411,** 144-148, 2017.
20. **Nishiguchi Katsuhiko, Yoshizumi Daisuke, Sekine Yoshiaki, Furukawa Kazuaki, Fujiwara Akira *and* Masao Nagase :** Planar cold cathode based on a multilayer-graphene/SiO2/Si heterodevice, *Applied Physics Express,* **Vol.9,** *No.10,* 105101-(4pp), 2016.
21. **Zhangcheng Liu, Jin-Ping Ao, Fengnan Li, Wei Wang, Jingjing Wang, Jinwen Zhang *and* Hong-Xing Wang :** Fabrication of three dimensional diamond ultraviolet photodetector through down-top method, *Applied Physics Letters,* **Vol.109,** 153507, 2016.
22. **Zhangcheng Liu, Jin-Ping Ao, Fengnan Li, Wei Wang, Jingjing Wang, Jingwen Zhang *and* Hong-Xing Wang :** Photoelectrical characteristics of ultrathin TiO2/diamond photodetector, *Materials Letters,* **Vol.188,** *No.2,* 52-54, 2017.
23. **Masao Nagase :** Observation of graphene on SiC using various types of microscopy, *THE HITACHI SCIENTIFIC INSTRUMENT NEWS,* **Vol.7,** 8-16, Sep. 2016.
24. **Shiro Sakai :** InGaAlN Multi-wavelength LEDs, *2016 10th Int. Conf. on New Diamond and Nano Carbons,* 180, Xi'an, May 2016.
25. **Taofei Pu, Fuzhe Zhang *and* Jin-Ping Ao :** Effect of Oxidation Treatment on Threshold Voltage of GaN MOSFETs Fabricated on AlGaN/GaN Heterostructure, *10th International Conference on New Diamond and Nano Carbons,* Xi'an, May 2016.
26. **Xinke Liu, Jin-Ping Ao, Jiazhu He, Jianfeng Wang, Wenjie Yu *and* Ke Xu :** 1200 V GaN Schottky Barrier Diode on 2'' Free-Standing Wafer using a CMOS-Compatible Gold-Free Process, *10th International Conference on New Diamond and Nano Carbons,* Xi'an, May 2016.
27. **Lei Wang, Yutaro Maeda, Yuyu Bu *and* Jin-Ping Ao :** Effect of UV/Ozone and Oxygen Plasma Treatment on AlGaN surface of AlGaN/GaN Ion-Sensitive Field-Effect Transistor, *10th International Conference on New Diamond and Nano Carbons,* Xi'an, May 2016.
28. **Shiro Sakai :** AlGaInN LEDs with a Temperature Gradient Method, *BIT's 5th annual world congress of advanced materials-2016,* 164, Chongqing, Jun. 2016.
29. **Kaoru Ohya :** Modelling secondary electron emission from nanostructured materials in scanning ion microscopes: some interesting similarities and differences from scanning electron microscopes, *1st International Conference on Helium Ion Microscopy and Emerging Focused Ion Beam Technologies, Keynote A1, 8-10 June 2016,* Luxemburg City, Jun. 2016.
30. **Kaoru Ohya :** Simulation of Ion Backscattering and Secondary Electron Emission from Crystal Surfaces Irradiated with Focused Ion Beams, *1st International Conference on Helium Ion Microscopy and Emerging Focused Ion Beam Technologies, P20, 8-10 June 2016,* Luxemburg City, Jun. 2016.
31. **Masao Nagase :** Single-crystal graphene growth on SiC by infrared rapid thermal annealing, --- [invited] ---, *2016 Collaborative Conference on 3D and Materials Research(CC3DMR),* inchon, Korea, Jun. 2016.
32. **Yoshitaka Nakano, Masahito Niibe *and* Retsuo Kawakami :** Electrical Damage Investigation of n-GaN Films Treated by CF4 Plasma, *Proceedings of the 43rd International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2016),* MoP-ISCS-LN-4\_1-MoP-ISCS-LN-4\_2, Toyama, Jun. 2016.
33. **Retsuo Kawakami, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano *and* Takashi Mukai :** Effect of Ultraviolet Light-Assisted CF4 Plasma Irradiation on AlGaN Thin Film Surface, *Proceedings of the 43rd International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2016),* MoP-ISCS-096\_1-MoP-ISCS-096\_2, Toyama, Jun. 2016.
34. **Yasushi Kanai, Takashi Ikuta, Takao Ono, Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi, Koichi Inoue *and* Kazuhiko Matsumoto :** Detection Kondo effect in Graphene Quantum Dots, *The 43rd International Symposium on Compound Semiconductor,* 7528502, Jun. 2016.
35. **Yoshiaki Taniguchi, Tsubasa Miki, Takanori Mitsuno, Yasuhide Ohno, Masao Nagase, Keiji Minagawa *and* Mikito Yasuzawa :** Hydrophilic Graphene Film by Molecular Functionalization, *The 43rd International Symposium on Compound Semiconductor,* Jun. 2016.
36. **Takanori Mitsuno, Yoshiaki Taniguchi, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Intrinsic pH Sensitivity of Graphene Field-Effect Transistors, *The 43rd International Symposium on Compound Semiconductor,* Jun. 2016.
37. **Takao Ono, Yasushi Kanai, Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi, Koichi Inoue *and* Kazuhiko Matsumoto :** An Application of Graphene Field Effect Transistor to Enzymatic Assay, *The 43rd International Symposium on Compound Semiconductor,* Jun. 2016.
38. **Yuusuke Takashima, Masato Tanabe *and* Yoshiki Naoi :** Highly polarized ultraviolet light control using Ge subwavelength grating, *The 2016 Asian Conference on Nanoscience and Nanotechnology,* 1P-011, Sapporo, Oct. 2016.
39. **Jin-Ping Ao, Tian Xie, Tong Zhang, Junshuai Xue *and* Yuyu Bu :** Synthesis and Applications of P-type Metal Oxides by Reactive Magnetron Sputtering, *12th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis (NMS-XII),* Changsha, Oct. 2016.
40. **Lei Wang, Jiaqi Zhang, Liuan Li, Junshuai Xue *and* Jin-Ping Ao :** Plasma-assisted low-temperature annealed ohmic process on AlGaN/GaN heterostructure field-effect transistors, *International Forum on Wide Bandgap Semiconductors China (IFWS 2016),* Beijing, Oct. 2016.
41. **Taniguchi Yoshiaki, Miki Tsubasa, Mitsuno Takanori, Yasuhide Ohno, Masao Nagase, Keiji Minagawa *and* Mikito Yasuzawa :** Protein adsorption characteristics on bare and phosphorylcholine-modified graphene films on SiC substrate, *29th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2016), No.11P-11-16,* Kyoto, Japan, Nov. 2016.
42. **Kitaoka Makoto, Nagahama Takuya, Nakamura Kohta, Takashima Kazuya, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Carrier doping effect of humidity for single-crystal graphene on SiC, *29th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2016), No.11P-11-24,* Kyoto, Japan, Nov. 2016.
43. **Yoshitaka Nakano, Masahito Niibe *and* Retsuo Kawakami :** Electrical damage in n-GaN films treated by CF4 plasma, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2016,* 73-74, Sapporo, Nov. 2016.
44. **Yasuhide Ohno, Takanori Mitsuno, Yoshiaki Taniguchi *and* Masao Nagase :** Intrinsic ion sensitivity of graphene field-effect transistors, *2016 Workshop on Innovative Nanoscale Devices and Systems,* Dec. 2016.
45. **Jin-Ping Ao, Naoto Okada, Taofei Pu, Hiroko Itoh *and* Yasuo Ohno :** GaN SBDs on Silicon Substrate for Microwave Power Rectification, *2016 Asia Wireless Power Transfer Workshop,* Chengdu, Dec. 2016.
46. **Yasuo OHNO, Hiroko ITOH *and* Jin-Ping Ao :** Reflection Control in Microwave Rectenna Using Integrated GaN SBD Configuration, *2016 Asia Wireless Power Transfer Workshop,* Chengdu, Dec. 2016.
47. **Taofei Pu, Tong Zhang, Lei Wang, Qian Huang *and* Jin-Ping Ao :** Enhancement-Mode GaN-Based High Electron Mobility Transistors With a Blocking Layer, *9th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials / 10th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science,* Mar. 2017.
48. **Yoshitaka Nakano, Masahito Niibe *and* Retsuo Kawakami :** Damage Introduced into n-GaN Films by CF4 Plasma Treatments, *9th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials (ISPlasma2017) and 10th Interational Conference on Plasma-Nano Technology & Science (IC-PLANTS2017),* Aichi, Mar. 2017.
49. **Masaharu Nishikino, Noboru Hasegawa, Takuro Tomita, Yasuo Minami, Takashi Eyama, Naoya Kakimoto, Rui Izutsu, Motoyoshi Baba, Tetsuya Kawachi *and* Tohru Suemoto :** Observation of fs-laser spallative ablation using soft X-ray laser probe, *Proceedings of SPIE,* **Vol.10091,** 100910O-1-100910O-5, San Francisco, Mar. 2017.
50. **草葉 啓太, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長格子/導波構造による二波長帯紫外光検出器の開発, *2016年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Bp-10, 2016年7月.
51. **岡本 裕, 髙島 祐介, 佐竹 正行, 田邉 聖人, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 高透過ストライプ状p型電極を用いたUV-LEDの光取り出し制御, *2016年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Bp-11, 2016年7月.
52. **橋本 拓哉, 植木 智之, 田中 康弘, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** SiC単結晶上に電子ビーム蒸着したニッケル薄膜の双晶化, *2016年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会講演概要集,* 26, 2016年7月.
53. **政井 勇輝, 植木 智之, 田中 康弘, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** Al/ダイヤモンド単結晶界面へのフェムト秒レーザ照射に伴う微細周期構造形成, *2016年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会講演概要集,* 27, 2016年7月.
54. **板東 洋太, 竹中 一将, 滝谷 悠介, 田中 康弘, 中島 信一, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** 極薄SiCにおけるラマンスペクトルの極性面依存性, *2016年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会講演概要集,* 44, 2016年7月.
55. **橋本 竜治, 鈴木 雄大, 西野 克志 :** 昇華法AlN基板上へのMOCVD法によるAlGaN結晶の成長, *2016年度 応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* 86, 2016年7月.
56. **梨子木 清人, 西野 克志 :** 6H-SiC基板上へのAlNバルク結晶成長, *2016年度 応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* 87, 2016年7月.
57. **多喜川 直也, 西野 克志 :** 剥離AlNを種結晶として用いた昇華法AlN成長, *2016年度 応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* 88, 2016年7月.
58. **森本 征士, 有月 琢哉, 青木 翔, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** 顕微ラマン分光法による SiC 上グラフェンの応力とキャリア密度の面内分布評価, *第77回応用物理学会秋季学術講演会(応物2016秋), No.13a-A32-3,* 2016年9月.
59. **山田 祐輔, 有月 琢哉, 高嶋 和也, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** 走査プローブ顕微鏡を用いた SiC 上グラフェンの実効ヤング率計測, *第77回応用物理学会秋季学術講演会(応物2016秋), No.13a-A32-4,* 2016年9月.
60. **平田 朋也, 酒井 士郎, 納田 卓, 木村 真大, 村本 宜彦 :** 中間板を用いたMOCVD-InGaN/GaN 四波長LED, *第77回 応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集,* 14a-A21-2, 2016年9月.
61. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長構造中の固有モード波数分散関係を用いた屈折率検出の高感度化, *第77回応用物理学会秋季学術講演会,* 15a-P5-14, 2016年9月.
62. **新部 正人, 川上 烈生, 中野 由崇, 田中 良, 荒木 佑馬, 東 知里, 向井 孝志 :** AlGaN 表面特性への酸素プラズマ照射効果, *第77回秋季応用物理学会学術講演会,* 2016年9月.
63. **北岡 誠, 永濱 拓也, 中村 晃大, 有月 琢哉, 高嶋 和也, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェンの水脱離による導電率変化, *第77回応用物理学会秋季学術講演会(応物2016秋), No.15p-A33-2,* 2016年9月.
64. **大野 恭秀, 光野 琢仁, 谷口 嘉昭, 永瀬 雅夫 :** グラフェン本来のイオンセンシング特性, *第77回応用物理学会秋季学術講演会(応物2016秋), No.15p-A33-10,* 2016年9月.
65. **川西 洋平, 酒井 士郎 :** MOCVDを用いた，GeドープAlGaNの成長, *第77回 応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集,* 16a-P5-26, 2016年9月.
66. **川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 東 知里, 向井 孝志 :** 紫外線照射下でのCF4 プラズマエッチングによるAlGaN表面ダメージ, *平成28年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 44, 2016年9月.
67. **北岡 誠, 永濱 拓也, 中村 晃大, 有月 琢哉, 高嶋 和也, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェンのシート抵抗の湿度依存性, *第8回集積化MEMSシンボジウム, No.25pm4-PM-016,* 2016年10月.
68. **谷口 嘉昭, 三木 翼, 光野 琢仁, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 南川 慶二, 安澤 幹人 :** 新規合成分子を用いた表面修飾による単結晶グラフェンの親水化, *第8回集積化MEMSシンボジウム, No.25pm4-PM-017,* 2016年10月.
69. **田邉 聖人, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 紫外域偏光制御におけるナノ周期構造の形状依存, *日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2016,* 1pP4, 2016年11月.
70. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 高屈折率差サブ波長周期構造を用いた広範囲な屈折率に対する高感度屈折率検出, *日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2016,* 1pP15, 2016年11月.
71. **佐竹 正行, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 表面実装サブ波長周期構造中の固有モードを用いた窒化物系 LED の放射パターン制御, *日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2016,* 1pP16, 2016年11月.
72. **谷口 嘉昭, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC上グラフェンのタンパク質吸着特性, --- ∼分子修飾による高性能バイオセンサの実現に向けて∼ ---, *サイエンスプラザ2016, No.52,* 2016年11月.
73. **中野 由崇, 新部 正人, 川上 烈生 :** CF4プラズマ処理したn-GaN膜の電気的ダメージ, *2016 真空・表面科学合同講演会，第36回表面科学学術講演会・第57回真空に関する連合講演会, No.1,* 2016年11月.
74. **板東 洋太, 滝谷 悠介, 田中 康弘, 中島 信一, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** 極薄SiCにおけるラマンスペクトルの極性面及び膜厚依存性, *第27回光物性研究会論文集,* **Vol.27,** 19-22, 2016年12月.
75. **大宅 薫 :** He, Ne, Gaイオンチャネリングへの照射ダメージ効果, *ナノテスティング学会 第9回先端計測技術研究会, 金沢工業大学大学院虎ノ門キャンパス,* 2016年12月.
76. **田中 良, 新部 正人, 川上 烈生, 中野 由崇, 向井 孝志 :** 酸素および窒素プラズマ処理したAlGaN膜の表面分析, *第30回日本放射光学会年会 放射光科学合同シンポジウム,* 2017年1月.
77. **荒木 佑馬, 新部 正人, 川上 烈生, 竹平 徳崇, 中野 由崇 :** TiO2薄膜のプラズマ処理試料のXPS法による組成と触媒活性の相関III, *第30回日本放射光学会年会 放射光科学合同シンポジウム,* 2017年1月.
78. **井筒 類, 近藤 恭介, 富田 卓朗 :** Linnik干渉計を用いたホウケイ酸ガラスにおけるフェムト秒レーザーアブレーション過程の観測, *レーザー学会学術講演会 第37回年次大会,* **Vol.37,** 20, 2017年1月.
79. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長周期構造を用いた垂直入射型屈折率高感度検出, *第64回応用物理学会春季学術講演会,* 14a-F202-8, 2017年3月.
80. **井筒 類, 近藤 恭介, 富田 卓朗 :** 透明固体材料における干渉計測によるフェムト秒レーザーアブレーション過程の観測, *第64回応用物理学会春季学術講演会,* 14p-512-2, 2017年3月.
81. **山崎 勇輝, 川上 博貴, 直井 美貴, 富田 卓朗 :** フェムト秒レーザーアニールによるp-GaN上へのNi/Auオーミック電極作製, *第64回応用物理学会春季学術講演会,* 15a-512-7, 2017年3月.
82. **川上 博貴, 直井 美貴, 富田 卓朗 :** フェムト秒レーザー支援アニールによるSiC上へのNi電極作製, *第64回応用物理学会春季学術講演会,* 15a-512-8, 2017年3月.
83. **朴 理博, 永瀬 雅夫, 大野 恭秀 :** 集束イオンビームを用いたステンシルリソグラフィ技術のための Sub10nm パターンの作製, *第64回応用物理学会春季学術講演会(応物2017春), No.15a-304-2,* 2017年3月.
84. **北岡 誠, 永濱 拓也, 中村 晃大, 有月 琢哉, 高嶋 和也, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェンの水吸着によるキャリア密度変化, *第64回応用物理学会春季学術講演会(応物2017春), No.15a-B6-6,* 15-084-(1pp), 2017年3月.
85. **谷口 嘉昭, 三木 翼, 光野 琢仁, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 南川 慶二, 安澤 幹人 :** 分子修飾機能化による SiC 上グラフェンの非特異吸着の抑制, *第64回応用物理学会春季学術講演会(応物2017春), No.15a-B6-7,* 15-085-(1pp), 2017年3月.
86. **草葉 啓太, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長格子/導波構造を有する二波長帯紫外光検出, *第64回応用物理学会春季学術講演会,* 16p-P13-9, 2017年3月.
87. **礒合 俊輔, 安澤 幹人, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェンの電気特性評価, *電気化学会第84回大会,* 2017年3月.
88. **川上 博貴, 近藤 健太, 直井 美貴, 富田 卓朗 :** 連続波レーザーアニールによるSiC上へのNi電極作製と評価, *第35回電子材料シンポジウム,* **Vol.114,** *No.338,* Fr1-5, 2016年7月.
89. **荒木 佑馬, 新部 正人, 川上 烈生, 竹平 徳崇, 中野 由崇 :** 酸素プラズマ処理したTiO2薄膜のXPSおよびNEXAFS法による組成・ダメージと触媒活性の相関, *第52回X線分析討論会,* 2016年10月.
90. **岡本 裕, 髙島 祐介, 直井 美貴 :** サブ波長周期構造電極を有する低光損失偏光UV-LEDの理論的検討, *LED総合フォーラム2016in徳島,* P-3, 2016年12月.
91. **佐竹 正行, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** FDTD法を用いたサブ波長周期構造によるLED放射パターンの理論的検討, *LED総合フォーラム2016in徳島,* P-4, 2016年12月.
92. **原口 雅宣, 木内 陽介, 北田 貴弘, 永瀬 雅夫, 安井 武史, 宮脇 克行, 髙橋 章, 岡久 稔也 :** LEDライフイノベーション総合プラットフォーム推進事業におけるテラヘルツLED応用基盤技術に関する取り組み, *LED総合フォーラム2016in徳島 論文集,* 201-202, 2016年12月.
93. **川上 烈生, 宮脇 克行, 白井 昭博, 東 知里, 冨士本 賢吾, 大塩 誠二, 山路 諭, 吉田 雅彦, 大西 和男, 大野 民之助, 松下 俊雄 :** LED光触媒ナノ粒子を使った鮮度保持技術の開発, *LED総合フォーラム2016 in 徳島,* 157-160, 2016年12月.
94. **富田 卓朗 :** (invited) フェムト秒レーザー照射を用いた原子拡散の新展開, *第12回励起ナノプロセス研究会,* 2017年3月.